

## Transistor Mosfet FQPF10N60C 600V 9.5A

Codigo: 113785



### Descripción

El 10N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Capacidad  $dv / dt$  mejorada
- Cambio rápido
- Carga de puerta baja (típico 44 nC)
- $C_{rss}$  bajo (típico 18 pF)
- Polaridad del transistor: Canal N
- Voltaje de drenaje a fuente  $V_{DS}$ : 600 V
- Voltaje de puerta a fuente  $V_{GS}$ :  $\pm 30$  V
- Corriente de drenaje  $I_D$ : 9.5 A
- Corriente de drenaje pulsada: 38 A
- Disipación de potencia ( $T_c=25^\circ\text{C}$ ): 156 W
- Resistencia de activación  $R_{ds(on)}$ : 0.73 ohm
- Temperatura de funcionamiento mínima:  $-55^\circ\text{C}$
- Temperatura de funcionamiento máxima:  $150^\circ\text{C}$
- Encapsulado: TO-220F
- Número de pines: 3